

ZXMP3F30FH

30V SOT23 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

Summary

$V_{(BR)DSS}$ (V)	$R_{DS(on)}$ (Ω)	I_D (A)
-30	0.080 @ $V_{GS} = -10V$	-4.0
	0.140 @ $V_{GS} = -4.5V$	

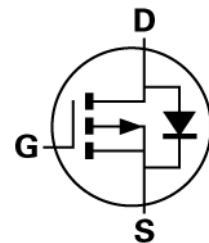


Description

This new generation Trench MOSFET from TY has been designed to minimize the on-state resistance ($R_{DS(on)}$) and yet maintain superior switching performance.

Features

- Low on-resistance
- Fast switching speed
- 4.5V gate drive capability
- Thermally enhanced SOT23 package

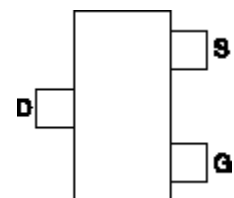


Applications

- Power management
- Portable Equipment
- Battery charging

Ordering information

Device	Reel size (inches)	Tape width (mm)	Quantity per reel
ZXMP3F30FHTA	7"	8mm	3,000



Pinout – top view

Device marking

KPA

ZXMP3F30FH

Absolute Maximum Ratings

Absolute maximum ratings

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-Source voltage	V_{DSS}	-30	V
Gate-Source voltage	V_{GS}	± 20	V
Continuous Drain current @ $V_{GS} = -10V$; $T_A = 25^\circ C$ (b) @ $V_{GS} = -10V$; $T_A = 70^\circ C$ (b) @ $V_{GS} = -10V$; $T_A = 25^\circ C$ (a) @ $V_{GS} = -10V$; $T_L = 25^\circ C$ (d)	I_D	-3.4 -2.7 -2.8 -4.0	V
Pulsed Drain current (c)	I_{DM}	-15.3	A
Continuous Source current (Body diode) (b)	I_S	-2	A
Pulsed Source current (Body diode) (c)	I_{SM}	-15.3	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (a) Linear derating factor	P_D	0.95 7.6	W mW/°C
Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (b) Linear derating factor	P_D	1.4 11.2	W mW/°C
Power dissipation at $T_L = 25^\circ C$ (d) Linear derating factor	P_D	1.96 15.7	W mW/°C
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to 150	°C

Thermal resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction to ambient (a)	$R_{\theta JA}$	131	°C/W
Junction to ambient (b)	$R_{\theta JA}$	89	°C/W
Junction to lead (d)	$R_{\theta JL}$	63.77	°C/W

NOTES:

- (a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
- (b) Mounted on FR4 PCB measured at $t \leq 10$ sec.
- (c) Repetitive rating on 25mm x 25mm FR4 PCB, $D=0.02$, pulse width 300us – pulse width limited by maximum junction temperature.
- (d) Thermal resistance from junction to solder-point (at the end of the drain lead).



ZXMP3F30FH

Electrical characteristics (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

Parameter	Symb ol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Static						
Drain-Source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	-30			V	$I_D = -250\mu\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$
Zero Gate voltage Drain current	I_{DSS}			-1.0	μA	$V_{DS} = -30\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$
Gate-Body leakage	I_{GSS}			100	nA	$V_{GS} = \pm 20\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$
Gate-Source threshold voltage	$V_{GS(th)}$	-1.0			V	$I_D = -250\mu\text{A}, V_{DS} = V_{GS}$
Static Drain-Source on-state resistance (*)	$R_{DS(on)}$			0.080 0.140	Ω	$V_{GS} = -10\text{V}, I_D = -2.5\text{A}$ $V_{GS} = -4.5\text{V}, I_D = -1.9\text{A}$
Forward Transconductance (*) (†)	g_{fs}		5		S	$V_{DS} = -15\text{V}, I_D = -3\text{A}$
Dynamic (†)						
Input capacitance	C_{iss}		370		pF	$V_{DS} = -15\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$
Output capacitance	C_{oss}		72		pF	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		38		pF	
Switching (‡) (†)						
Turn-on-delay time	$t_{d(on)}$		1.3		ns	$V_{DD} = -15\text{V}, V_{GS} = -10\text{V}$ $I_D = -1\text{A}$ $R_G \cong 6.0\Omega,$
Rise time	t_r		2.6		ns	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		49		ns	
Fall time	t_f		22		ns	
Gate charge						
Total Gate charge	Q_g		7		nC	$V_{DS} = -15\text{V}, V_{GS} = -10\text{V}$ $I_D = -3\text{A}$
Gate-Source charge	Q_{gs}		1.2		nC	
Gate-Drain charge	Q_{gd}		1.3		nC	
Source-Drain diode						
Diode forward voltage (*)	V_{SD}		-0.80	-1.2	V	$I_S = -1.7\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$
Reverse recovery time (‡)	t_{rr}		14.6		ns	$I_S = -1.5\text{A}, di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$
Reverse recovery charge (‡)	Q_{rr}		9.5		nC	

NOTES:

- (*) Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.
- (†) Switching characteristics are independent of operating junction temperature.
- (‡) For design aid only, not subject to production testing



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.